

主页

科研团队

研究领域

论文成果

专利成果

项目经费

科研活动

仪器设备

招贤纳士

专利成果

当前位置: 首页 > 科学研究 > 微纳宽禁带与柔性电子器件研究室 > 专利成果 > 正文

2018年专利

发布日期: 2019-06-18 点击: 113

[1] “具有顶栅和底栅结构的氧化镓薄膜场效应晶体管”，授权专利号201820502148.9，发明专利，发明人：徐明升;宋爱民;辛倩;刘雅璇;杜璐璐，

[2] “一种可靠的双极性SnO薄膜晶体管”，授权专利号ZL201821041378.6，实用新型专利，发明人：辛倩，宋爱民，屈云秀。

[3] “一种高频半导体薄膜晶体管”，授权专利号ZL201821042302.5，实用新型专利，发明人：王一鸣，梁广大，宋爱民，辛倩。

[4] Device and Method, UK Patent Application No 1803169.0, Jiawei Zhang, Josh Wilson,Aimin Song, Filed on 27 Feb 2018.

[5] Plasma wave laser, UK Patent Application No 1802960.3, Kunyuan Xu,Aimin Song, Filed on 23 Feb 2018.

毕业学生

[6] A3method of producing double gate Ga2O5 thin film transistors, Mingsheng Xu,Aimin Song, Qian Xin, Yaxuan Liu, Lulu Du, filed on 20 Jan, 2018

【关闭】

上一条：2017年专利

--山大部门学院网站--



--国内高校微电子学院网站--



--国外相关研究机构网站--



--友情链接--



--友情链接--



地址：山东省济南市高新区舜华路1500号山东大学软件园校区

邮编：250101

电话：(86) -531-88390136 传真：(86) -531-88390136

版权所有 © 山东大学微电子学院 鲁ICP备案 05001952号



关注微信



关注微博